



Daniele Spucches

Nazionalità: Italiana Data di nascita: 02/12/1985 Sesso: Maschile

☎ Numero di telefono: (+39) 3891018059

✉ Indirizzo e-mail: daniele.spucches@hotmail.it

✉ Indirizzo e-mail: daniele.spucches@istitutovanonimenaggio.edu.it

📍 Abitazione: Via A.Volta n° 4, 22010 Carlazzo (Italia)

ESPERIENZA LAVORATIVA

Docente di scuola secondaria

I.I.S.S EZIO VANONI Menaggio [09/2022 - Attuale]

Città: Menaggio (CO)

Paese: Italia

Matematica e Fisica

Tutor interno nel progetto PON "Coding e Robotica"

Istituto Comprensivo Statale di Dongo [2022]

Città: Dongo (CO)

Paese: Italia

Docente di scuola secondaria

Istituto Comprensivo Statale di Dongo [08/09/2021 - 30/06/2022]

Città: Dongo

Paese: Italia

Matematica e scienze

Docente di scuola secondaria

I.I.S.S EZIO VANONI Menaggio [09/2019 - 06/2021]

Città: Menaggio (CO)

Paese: Italia

Informatica e Matematica

Docente di scuola secondaria

Istituto Comprensivo Cernobbio [03/2019 - 06/2019]

Città: Cernobbio (CO)

Paese: Italia

Sostegno

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea Magistrale in Fisica

Università Degli Studi di Catania [10/2012 - 10/2016]

Città: Catania (CT)

Paese: Italia

Sito web: www.unict.it

Campi di studio: Fisica della Materia

Voto finale: 109/110 – **Livello EQF:** Livello 7 EQF

Tesi: Effetto del PH sull'attività fotocatalitica di nanoparticelle di TiO₂ prodotte per ablazione laser pulsato in liquido.

Meccanica quantistica, Ottica quantistica, Struttura della materia, Fisica dello stato solido, Fisica dei materiali, Fisica dei semiconduttori, Fisica delle nanostrutture, Spettroscopia.

Utilizzo dei principali strumenti di caratterizzazione dei materiali (XRD, SEM, TEM, RBS, AFM, 4PP, spettrofotometria) e analisi dati.

Laurea in Fisica

Università Degli Studi di Catania [10/2005 – 10/2012]

Città: Catania (CT)

Paese: Italia

Sito web: www.unict.it

Diploma

Liceo scientifico "Michele Amari" [2005]

Città: Giarre

Paese: Italia

COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre: **Italiano**

Altre lingue:

Inglese

ASCOLTO B1 LETTURA B2 SCRITTURA A2

PRODUZIONE ORALE A2 INTERAZIONE ORALE A2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

COMPETENZE DIGITALI

Strumenti Microsoft Office: PowerPoint, Excel, Word, Outlook, OneDrive / Programmazione in Matlab e in C++ / Software dedicati all'analisi dati

PUBBLICAZIONI

Chemical Vapor Deposition Growth of Silicon Nanowires with Diameter Smaller Than 5 nm

[2019]

R. A. Puglisi, C. Bongiorno, S. Caccamo, E. Fazio, G. Mannino, F. Neri, S. Scalese, D. Spucches, A. L. Magna, ACS omega [American Chemical Society], Volume: 4 Issue: 19 Pages: 17967 - 17971

Transparent conductive polymer obtained by in - solution doping of PEDOT:PSS

[2018]

V. Lombardo, L. D'urso, G. Mannino, S. Scalese, D. Spucches A. La Magna, A. Terrasi and R.A. Puglisi, Polymer, Vol 155, Pages 199 - 207

Optical and morphological evolution of black TiO_x synthesized in water by Nd:YAG laser

[2017]

D. Spucches, M. Zimbone, G. Cacciato, F. Ruffino, V. Privitera, and M. G. Grimaldi Phys. Status Solidi C 14, No. 9, 1700134 (2017) / DOI 10.1002/pssc.201700134

PATENTE DI GUIDA

Patente di guida: B

CONFERENZE E SEMINARI

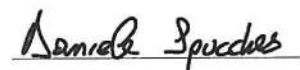
International Conference on Semiconductors, Optoelectronics and Nanostructures

[Parigi, 20/08/2018 – 21/08/2018]

Speaker sull'articolo "Thermodynamical conditions for the synthesis of 5 nm sized silicon nanowires by vapour-liquid-solid growth".

Il sottoscritto Daniele Spucches, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae corrispondono a verità, essendo consapevole dell'eventuale applicazione dell'art.76 dello stesso articolo in caso di dichiarazione mendace; Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Menaggio, 31/01/2024



Daniele Spucches

